「微粒子イオンビーム堆積法と半導体量子ドット 発光型無機エレクトロルミネッセンス素子」

HOYA株式会社 R&Dセンター

谷 由紀,小林 哲

Nanoparticle ion Beam deposition method and semiconductor quantum dot activated inorganic electroluminescent device.

Yuki Tani, Satoshi Kobayashi R&D Center, HOYA Corporation

1. はじめに

半導体ナノ微粒子,または量子ドットと呼ば れる蛍光体とその応用が注目されている。¹¹量子 ドットはイオンをドープしていない直径数ナノ メートルの球状の無機半導体材料で,その直径 を変えることにより蛍光波長の調整が可能であ ること,高い発光効率を持つこと,イオン性発 光中心に見られる濃度消光がないことなどの素 晴らしい特徴を持つ。そこで我々はこの特徴を 活かすべく,量子ドットを活性層に用いた発光 素子の開発に取り組んだ。

特に高い発光効率を示すコロイダル量子ドットは溶液中で合成され,溶液に分散された形態 で供給される。これを固体素子化するには新た な技術が必要であった。我々はまず,液体中に 分散された微粒子を真空中で薄膜化する技術,

「イオンビーム堆積法」を開発した。^{2.3}この堆積 法は通常デバイス作製で使用される真空成膜技 術との相性がよい。この方法を用いて「量子ド ット発光型の無機エレクトロルミネッセンス (EL)素子」を製作し,量子化準位からの発光 を実現した。⁴⁾この二つの技術を簡潔に紹介する。

2. 微粒子イオンビーム堆積法

コロイド溶液から溶媒だけを取り除き,分散 している微粒子を真空チャンバー内でソフトラ ンディングさせ薄膜化するというコンセプト (図1)を実現するのが「液体分散量子ドット イオンビーム堆積装置(LIQUID)」である。「エ レクトロスプレー・イオン化(Electrospray ionization)」と「自由噴流(Free jet)」を用い た独自の構成を採っている。本紹介では,既に 実績のある質量 3000~250000 amu 程度の量子 ドットの薄膜化を取り上げるが,この装置で堆 積できる微粒子は量子ドットに限らず,多様な 液体に分散した分子量の大きな物質を薄膜化す ることが可能である。

LIQUID の装置構成の模式図を図2に示した。LIQUID は5つのコンポーネントで構成されており、それぞれの役割を図2中の表にまとめた。量子ドット堆積の過程をコロイド溶液から基板に到達するまで順を追って説明する。

原料はCSe/ZnSコア/シェル型量子ドット を使用した。通常はトルエンに分散されてお り、シェル表面はトリオクチルホスフィン酸化 物(TOPO) やその他の有機リガンドで被覆さ

^{〒196-8510} 東京都昭島市武蔵野 3-3-1 TEL 042-546-2730 FAX 042-546-2742 E-mail:tani@sngw.rdc.hoya.co.jp



図1 (a)液体分散量子ドットイオンビーム堆積機構(LIQUID)の概念。大気圧雰囲気中のコロイド 状分散液から量子ドットを取り出し、エネルギーを付与、基板まで運び衝突、堆積させる。

(b)通常のイオンビーム堆積法における入射粒子の持つ運動エネルギーの効果と LIQUID 法で 用いる運動エネルギー領域との比較。

れている。膜堆積時にはトルエンの他にいくつ かの溶媒を混合して使用した。また水分散のコ ロイド溶液ではエレクトロスプレーが安定する ため、無極性溶媒を使った上記の量子ドット堆 積よりもさらに堆積は容易になる。

LIQUID のプロセスは,初め溶媒中に分散さ れた状態の量子ドットが「エレクトロスプレイ ヤー」でイオン化され,大気中へ放出される。 さらに「フリージェットノズル」を介して最初 の真空領域に入るまでの間に,溶媒は蒸発し, 自身の静電反発力により微細な液滴は分裂を繰 り返す。溶媒を失った量子ドットはフリージェ ットノズル通過後,気流の流れに巻き込まれて 加速される。この時すべての量子ドットイオン がその分子量に関わらず等速(気流と同速度) になり,運動エネルギーを付与されイオンビー ムを形成する。その後は「イオン光学系」によ り,イオンビームはコリメートされ,さらに 「エネルギーアナライザー」で不要な溶媒分子 や,質量の大きすぎる複合体を [m/z] で分離



図2 LIQUID 装置の模式図と主要な5つのコンポーネントの機能

し、適当なエネルギー(質量/電荷)を持つイ オンビームのみを100℃程度に加熱した基板に 照射し、堆積させる。現在、実測のイオンビー ムのエネルギーは5-7 keVであり、数個の量 子ドットとリガンドがクラスターイオンを形成 していると考えられる。量子ドットイオンが基 板に衝突し付着する際には0.3 eV/atom 程度 の付与された運動エネルギーを散逸させる。こ の値はリガンドとの結合(0.eV/bond程度) は切れるが、CdSe、ZnS(1 eV/bond程度) の共有結合は切れないと予想され、また下地層 との反応も起さないというソフトな堆積に適し ている(図1(b))。^{5.6.7.8)}また、LIQUIDでイオ ンに与える速度エネルギーは試料導入インター フェース部の設定によって調節,決定できる。^{2,3)}

実際に堆積した量子ドット膜の透過型電子顕 微鏡像を図3(a)に示す。また堆積膜と原料の コロイド溶液のフォトルミネッセンス(PL) を比較を図3(b)に示す。原料の量子ドットを 薄膜化し、堆積の衝撃によってPL活性を失う ことなく、その機能を保持することに成功し た。堆積膜は原料のコロイド溶液と較べると大 部分のリガンドが除去されていることが分かっ ている。^{2.3)}



図3 (a) LIQUID 法で堆積した量子ドット膜の断面透過型電子顕微鏡像。 (b) 原料量子ドット溶液と堆積膜のフォトルミネッセンス(PL) スペクトルの比較。 (c) 量子ドット発光型無機エレクトロルミネッセンス素子(Q-EL)の構造の模式図。 (d) Q-EL の PL とエレクトロルミネッセンス(EL) スペクトルの比較。挿入図は非駆動時 の発光素子の外観写真。

3.量子ドット発光型無機エレクトロルミ ネッセンス素子

発光強度 (a.n.)

先に解説した LIQUID を用い,量子ドット の発光層を持つ素子を作製した。この素子は溶 媒分散した量子ドットを原料に用い,かつ全て の材料が無機物で形成されている点では世界初 の発光素子である。量子ドットの量子閉じ込め 効果によって,発光スペクトルの調整が容易で あり,フルカラー RGB 発光時には高い色再現 性が期待できる。また量子ドットを使った有機 EL 型素子^{9.10}と較べて耐久性が望める。

素子構造は図3(c)に示した。量子ドットを 含む発光層を絶縁体の層で挟み込み,さらにこ れを電極で挟む,二重絶縁型無機EL構造をと っている。この構造の特徴は電極の仕事関数に 制約がないため,電極材料を自由に選択でき, 透明導電性酸化物を電極に用いればシースルー 発光素子が実現できることである。また,高温 のプロセスがないためプラスチック基板上に素 子を形成できる。素子の写真を図3(d)挿入図 に示す。交流電圧駆動で発光する。室温でのEL スペクトル (100 kHz, 160 Vp-p)を図3(d)に 示す。図3(b)のPLとELスペクトルを比較す ると,ほぼ同じ形状を示しており,量子ドット の持つ量子化準位からの発光をELでも再現で きたことがわかる。筆者らはスピンコート法に よって作製した量子ドット発光層を用いて同じ 構造の発光素子試作も試みた。その場合には量 子化準位からの鋭い発光ピークは確認できなか った。よって,LIQUIDで作製した量子ドット 堆積膜がよりエレクトロニクス用途に適すと考 えている。

量子ドット型無機 EL は素子に印加した電界 によって絶縁層と発光層の界面から放出したト ンネル電子が電界によって加速され,量子ドッ トに衝突し発光すると考えている。発光中心に 量子ドットを採用することの利点として,発光 色をコントロールできること,通常の蛍光体の イオン性発光中心と比較して電子の衝突確率が 高いことが上げられる。そのため発光層の厚み は通常の薄膜無機 EL の ZnS: Mn 発光層と較 べて薄くすることができると考えられ,結果的 に低電圧駆動が可能になる。

4. おわりに

無機 EL は自発光, 高耐久性, 高速応答を特 徴とする次世代ディスプレイとして期待されて いる。しかし, これまでは発光色に問題を抱え てきた。我々は新規の特性を持つ量子ドット蛍 光体を用いることで,フィルターレスの純色自 発光素子, 完全透明フルカラーディスプレイへ の第一歩を踏み出せたと自負している。今後, この技術を他の技術と融合させることで新たな 技術革新を起こすことを目指している。

また今回,量子ドット発光素子を実現するに 当たって,汎用性の高い液体分散微粒子の真空 堆積装置の開発に成功した。この技術の用途は CdSe/ZnS量子ドットだけに留まるものではな いので,広い技術分野で利用されることを願っ ている。 謝辞 共同研究者の川副博司東京工業大学名誉 教授(川副フロンティアテクノロジー(株) に感謝する。

参考文献

- 1) 村瀬至生, NEW GLASS, 22, 19 (2007)
- 2) S. Kobayashi, Y. Tani, H. Kawazoe, Jpn. J. Appl. Phys., 46, L 392 (2007)
- 3) Y. Tani, S. Kobayashi, H. Kawazoe, Jpn. J. Appl. Phys., 47 印刷中 (2008)
- 4) S. Kobayashi, Y. Tani, H. Kawazoe, Jpn. J. Appl. Phys., 46, L 966 (2007)
- 5) 菅田栄治編,電子・イオンビームハンドブック(日 刊工業新聞社 1998年)
- 6) I. Moreels, J. C. Martins, Z. Hens, ChemPhysChem, 7, 1028 (2006)
- 7) K. Bromann, C. Felix, H. Brune, W. Harbich, R. Monot, J. Buttet, K. Kern, Science, **274**, 956 (1996).
- 8) S. Rauschenbach, F. L. Stadler, E. Lunedei, N. Malinowski, S. Koltsov, G. Costantini, K. Kern, Small, 2, 540 (2006).
- 9) V. L. Colvin, M. C. Schlamp, A. P. Alivisatos, Nature, 370, 354 (1994).
- S. Coe, W. K. Woo, M. Bawendi, V. Bulovic, Nature, 420, 800 (2002).